

Spezifikationen	
Teilenummer	FQU2N90TU_WS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2577 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 850mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

sein:

YIC

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

FQU30N06
FAIRCHI
FAIRCHI TO-251



FQU2N90TU
Fairchild/ON Semiconductor
MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

FQU30N06L MOS
VBSEMI
VBSEMI I-PAK



FQU2N90TU
 AMI Semiconductor / ON
 Semiconductor
 MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK



 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

FQU30N06L
 F
 FQU30N06L F



Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited